



Филиал в г. Чебоксары: 428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 90/1, тел./факс: (8352) 28-63-55 / 28-64-77

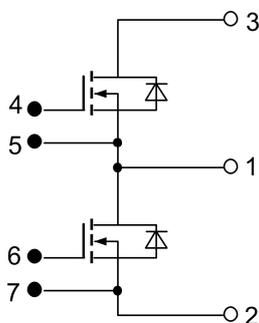
М2ТКП-350-1

-Напряжение пробоя изоляции 2500В

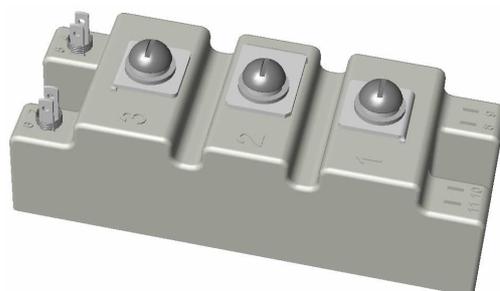
-Легко параллелятся

-Низкое сопротивление $R_{ds(on)}$

-Допускают высокие скорости нарастания напряжения



$U_{ds}=100$ В
 $R_{ds(on)}=4$ МОм
 $I_d=350$ А ($T=25^\circ\text{C}$)



габариты: 94x34x36 мм
установочные размеры: 80 мм
масса, не более: 200 г

Предельно допустимые значения параметров модуля М2ТКП-350-1

$T_j=25^\circ\text{C}$, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	М2ТКП-350-1	
			не менее	не более
Пробивное напряжение изоляции, В	V_{isol}	$f=50$ Гц, $t=1$ мин	2500	
Напряжение сток-исток, В	$V_{ds\ max}$	$V_{gs}=0$ В, $I_d \leq 200$ нА	100	
Напряжение сток-затвор, В	$V_{dg\ max}$	$V_{gs}=0$ В, $R_g=20$ кОм, $I_d \leq 0,25$ мА	100	
Напряжение затвор-исток, В	V_{gs}	$V_{ds}=0$ В, $I_{gss}=100$ нА		± 20
Номинальный постоянный ток стока, А	$I_{d\ ном}$	$V_{gs}=10$ В, $T_j=25^\circ\text{C}$, $T_j=100^\circ\text{C}$	350 230	
Импульсный ток стока, А	I_{dm}	$T_j \leq 125^\circ\text{C}$, $V_{gs}=\pm 15$ В, $L_s \leq 50-70$ нГн, $t_p \leq 10$ мкс, $D \leq 0,2\%$	1350	
Рассеиваемая мощность, Вт	P_D			780
Постоянный ток обратного диода, А	$I_{F\ ном}$	$V_{gs}=0$ В, $T_j=25^\circ\text{C}$, $T_j=100^\circ\text{C}$ $T_j \leq T_{j\ max}$	350 230	

Импульсный ток обратного диода, А	I_{FM}	$V_{gs}=0\text{ В},$ $T_j=25^\circ\text{C},$ $T_j \leq T_{j\text{ max}},$ $t_p \leq 10\text{ мкс},$ $D \leq 2\%$	1350	
Рабочая температура кристалла, °C	T_j		-50 ÷ +150	
Температура хранения	T_{STG}		-50 ÷ +125	

Статические параметры модуля M2ТКП–350–1

$T_j=25^\circ\text{C}$, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	M2ТКП–350–1	
			не менее	не более
Напряжение пробоя сток-исток, В (допустимый ток утечки стока, мА)	$V_{(br)dss}$	$V_{gs}=0\text{ В},$ при $I_d \rightarrow \text{мА}$	100	
			0,25	
Пороговое напряжение затвор-исток, В	$V_{gs(th)}$	$V_{gs}=V_{ds},$ при $I_d \rightarrow \text{мА}$	2	4,5
			0,25	
Начальный ток стока, мА	$I_{dss(0)}$	$T_j=25^\circ\text{C},$ $T_j=125^\circ\text{C},$ $V_{gs}=0\text{ В},$ $V_{dd}=V_{ds}=20\text{ В}$		0,4 3
Ток утечки затвор-исток, мА	I_{gss}	$V_{gs}=\pm 20\text{ В},$ $V_{ds}=0\text{ В}$		± 200
Тепловое сопротивление кристалл-корпус МОП-транзистора, °C/Вт	R_{thjc}	$T_j \leq 150^\circ\text{C}$		0,13*
Сопротивление ключей в открытом состоянии, МОм	$R_{ds(on)}$	$V_{gs}=10\text{ В},$ $T_j=25^\circ\text{C},$ $T_j=125^\circ\text{C},$ $t_p \leq 200\text{ мкс},$ $D \leq 0,005,$ при $I_d \rightarrow \text{А}$		4 7,8
			230	
Прямое падение напряжения на обратном диоде, В	V_{FM}	$V_{gs}=0\text{ В},$ $t_p \leq 80\text{ мкс},$ $D \leq 2\%,$ при $I_f \rightarrow \text{А}$		1,3
			230	

* для модуля

Динамические параметры модуля M2ТКП–350–1

$T_j=25^\circ\text{C}$, если не указано другое

Наименование параметра, единицы измерения	Обозначение	Условия измерения	M2ТКП–350–1	
			типовое	не более
Входная емкость, нФ	C_{iss}	$V_{gs}=0\text{ В},$ $f=1\text{ МГц},$ $V_{dd}=25\text{ В}$	14,7	
Выходная емкость, нФ	C_{oss}	$V_{gs}=0\text{ В},$ $f=1\text{ МГц},$ $V_{dd}=25\text{ В}$	1,4	
Проходная емкость, нФ	C_{rss}	$V_{gs}=0\text{ В},$ $f=1\text{ МГц},$ $V_{dd}=25\text{ В}$	0,9	
Полный заряд затвора, нКл	Q_g	$I_d=230\text{ А},$ $V_{dd}=50\text{ В}$	420	580
Время задержки включения, нс	$t_{d(on)}$	$V_{gs}=10\text{ В},$ $R_g=3,3\text{ Ом},$ $t_p \leq 300\text{ мкс},$ $D \leq 2\%,$ $T_j=125\text{ }^\circ\text{C},$	60	95
Время нарастания, нс	t_r		90	135
Время задержки выключения, нс	$t_{d(off)}$		90	150
Время спада, нс	t_f		85	150
Время восстановления обратного диода, нс	t_{rr}	при $I_d \rightarrow \text{А},$ при $V_{dd} \rightarrow \text{В}$	230 50	
Полный заряд затвора, нКл	Q_{rr}		70	90
			80	
		при $I_f \rightarrow \text{А},$ при $V_R \rightarrow \text{В}$	230 50	

